## アルキル鎖長の異なる poly(3-alkylthiophene)を用いた トップゲート有機トランジスタのデバイス特性

Device characteristics of top-gate organic transistors using poly(3-alkylthiophene) with different alkyl chain lengths

<sup>1</sup> 大阪府大院工, <sup>2</sup> 大阪府大 分子エレクトロニックデバイス研 〇高木 謙一郎 <sup>1</sup>, 永瀬 隆 <sup>1,2</sup>, 小林 隆史 <sup>1,2</sup>, 内藤 裕義 <sup>1,2</sup> <sup>1</sup> Osaka Pref. Univ., <sup>2</sup> RIMED

OK. Takagi<sup>1</sup>, T. Nagase<sup>1,2</sup>, T. Kobayashi<sup>1,2</sup>, and H. Naito<sup>1,2</sup> E-mail: takagi@pe.osakafu-u.ac.jp

1. **はじめに** Polythiophene にアルキル側鎖を導入し、有機溶媒に可溶化した poly(3-alkylthiophene) (P3AT) は代表的な有機半導体高分子材料である。特にヘキシル基を持つ poly(3-hexylthiophene) (P3HT) は高いキャリア移動度と高い溶解性を併せ持つことから、有機 FET のみならず、有機太陽電池の分野でも盛んに用いられている。有機 FET において、ボトムゲート構造による P3AT の移動度のアルキル鎖長依存性は幾つかのグループにより報告されている[1]が、トップゲート構造による詳細な報告はこれまでになされていない。本研究では、トップゲート構造を有する P3AT FET の移動度のアルキル鎖長依存性を調べることを目的とした。

2. **素子作製** 半導体材料として、ヘキシル基 (C=6)、オクチル基 (C=8)、デシル基 (C=10) を持つ regioregular P3AT (それぞれ P3HT、P3OT、P3DT と呼ぶ) を用いた。フォトリソグラフィによりガラス 基板上に Au ソース・ドレイン電極を形成した。基板上に無水クロロベンゼンに溶解した P3AT をスピ

ンコートし、乾燥させた後、更にゲート絶縁膜として CYTOP、poly(4-chlorostyrene) (PCS)、あるいは poly(menthylmethacrylate) (PMMA) をスピンコートした。最後に Al ゲート電極を真空蒸着することでトップゲート型 FET を作製した。また比較として、 $UV/O_3$  及び octadecyltrichlorosilane (ODTS) で表面処理した  $n^+$ -Si/Si $O_2$  基板を用いて、ボトムゲート型 P3AT FET を作製した。

3. 結果及び考察 図1にトップゲート型及びボトムゲート型 P3AT FET の電界効果移動度のアルキル鎖長依存性を示す。UV/O<sub>3</sub> 処理 基板上のボトムゲート P3AT FET においては、過去の報告[1]と同様に移動度はアルキル鎖長の増加に伴って 1 桁以上低下した。一方、トップゲート型 P3AT FET では、ODTS 処理基板上のボトムゲート型 FET と同程度の高い移動度を示し、アルキル鎖長の増加に対する移動度の低下は僅かであった。図 2 にゲート絶縁膜の比誘電率に対するトップゲート型 P3AT FET の移動度を示す。いずれのP3ATを用いた場合でも移動度の比誘電率に対する依存性は見られず、ダイポールディスオーダによる移動度低下が抑制されることが分かった。これらの結果は、トップゲート型 FET においてキャリア輸送領域となる半導体薄膜表面において、P3AT 分子がアルキル鎖長に依らずに edge on 配向していることを明確に示している[2]。トップゲート構造を用いることで、アルキル側鎖の増加に伴うP3AT FET の移動度低下が抑制できることが明らかとなった。

**参考文献** [1] 例えば K. Kaneto *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys., **39**, L872 (2000). [2] 高木他, 第 73 回応用物理学会学術講演会 講演予稿集, 12-243 (2012).

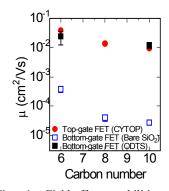


Fig. 1. Field-effect mobilities of top-gate and bottom-gate P3AT FETs as a function of alkyl chain length.

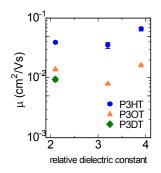


Fig. 2. Field-effect mobilities of top-gate P3AT FETs as a function of the relative dielectric constant of gate insulators.